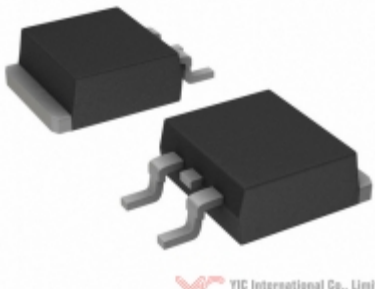

	<h2 style="color: red;">FQB19N10TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB19N10TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK
	Datenblätter:  FQB19N10TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 38163 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB19N10TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	38163 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 19A (Tc) 3.75W (Ta), 75W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)







FQB19N10TM ist neu im Original, Suche FQB19N10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB19N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB19N10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB19N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK</p>	 <p>FQB19N20CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A D2PAK</p>	 <p>FQB19N20C F FQB19N20C F</p>	 <p>FQB19N10LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK</p>
 <p>FQB17P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.5A D2PAK</p>	 <p>FQB19N10 FSC FSC TO-263</p>	 <p>FQB19N20 F FQB19N20 F</p>	 <p>FQB19N10L Fairchild/ON Semiconductor FQB19N10L FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

 FQB12N60TM_AM002	 FQB12P10	 FQB12P10TM	 D FQB12P10TM	 FQB12P20
 FQB12P20TM	 FQB12P20TM	 D FQB13N06L	 FQB13N10	 FQB13N10L
 FQB13N50	 FQB13N50CTM	 FQB13N50CTM	 FQB140N03L	 FQB14N30TM
 D FQB14N30TM	 FQB16N25TM	 FQB16N25TM	 FQB17P06	 FQB17P10
 FQB17P10TM	 FQB17P10TM	 FQB19N10L	 FQB19N10LTM	 FQB19N10LTM
 FQB19N10TM	 FQB19N20	 D FQB19N20C	 FQB19N20CTM	 FQB19N20CTM
 FQB19N20L	 D FQB19N20LTM	 FQB19N20LTM	 FQB19N20TM	 FQB19N20TM
 FQB1N60TM	 FQB1N60TM	 FQB20N06L	 FQB20N60FTM	 FQB20N60TM
 FQB22P10	 FQB22P10TM	 FQB22P10TM	 D FQB22P10TM_F085	 FQB24N08TM
 FQB24N08TM	 FQB25N33	 FQB25N33TM	 FQB25N33TM	 FQB25N33TM_F085

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited